

光存储技术研究进展

郑晨溪

(沈阳航空工业学院, 辽宁沈阳 110136)

摘要: 本文介绍了光存储研究的进展。阐述和分析了光盘存储、蓝光存储、近场光存储、多阶光存储和全息光存储等技术的基本原理以及发展水平。

关键词: 光存储; 光盘; 蓝光激光二极管; 近场; 全息

伴随信息资源的数字化和信息量的迅猛增长, 对存储器的存储密度、存取速率及存储寿命的要求不断提高。在这种情况下, 光存储技术应运而生。光存储技术具有存储密度高、存储寿命长、非接触式读写和擦出、信息的信噪比高、信息位的价格低等优点^[1]。本文简要介绍光存储技术的发展与现状。

1 光存储技术原理

光存储技术是采用激光照射介质, 激光与介质相互作用, 导致介质的性质发生变化而将信息存储下来的。读出信息是用激光扫描介质, 识别出存储单元性质的变化。

在实际操作中, 通常都是以二进制数据形式存储信息的, 所以首先要将信息转化为二进制数据。写入时, 将主机送来的数据编码, 然后送入光调制器, 这样激光源就输出强度不同的光束。此激光束经光路系统、物镜聚焦后照射到介质上(焦点处记录斑直径正比于波长 λ , 反比于聚焦系统的数值孔径 NA), 其中一种存储方法是介质被激光烧蚀出小凹坑。介质上被烧蚀和未烧蚀的两种状态对应着两种不同的二进制数据。识别存储单元这些性质变化, 即读出被存储的数据。具体阐述如下:

1.1 只读式光盘 记录信息: 记录介质为涂有光刻胶的玻璃盘基。在调制后的激光束的照射下, 再经过曝光、显影、脱胶等过程, 正像母盘上就出现凹凸的信号结构。之后利用蒸发和电镀技术, 得金属负像母盘, 最后用注塑法或光聚合法在金属母盘上复制光盘。读出信息: 激光照射在凹坑上, 利用凹坑与周围介质反射率差别读出信息。

1.2 CD-R 光盘 记录信息: 利用热效应。用聚焦激光束照射 CD-R 光盘中的有机染料记录层, 照射点的染料发生汽化, 形成与记录信息对应的坑点, 完成信息的记录。读出信息: 利用坑点与周围介质反射率的区别。

1.3 可擦写光盘

1.3.1 相变型存储材料的光盘 记录信息: 高功率调制后的激光束照射记录介质, 形成非晶相记录点。非晶相记录点的反射率与未被照射的晶态部分有明显的差异。读出信息: 用低功率激光照射存储单元, 利用反射光的差异读出信息。信息的擦除: 相记录点在低功率、宽脉冲激光照射下, 又变回到晶态。

1.3.2 磁光存储材料的光盘 记录信息: 记录介质为磁化方向单向规则排列的垂直磁光膜。在聚焦激光束照射下, 发生热磁效应, 记录点的磁化方向发生变化, 进而完成信息记录。读出信息: 利用法拉第效应和克尔效应。信息的擦除: 在激光的作用下, 改变偏磁场的方向, 删出了记录信息。

2 第一代、第二代光盘技术

多媒体信息时代的第一次数字化革命是以直径为 12cm 的高音质 CD (Compact disc) 光盘取代直径为 30cm 的密纹唱片。这其中包括 CD-ROM, CD-R 和 CD-RW 类型。CD 光盘使用的激光波长为 780nm, 数值孔径为 0.45, 道间距为 1.6μm, 存储容量为 650MB。

第二代数字多用光盘 DVD (Digital Versatile Disk) 使用的激光波长为 635/650nm, 数值孔径为 0.6, 道间距为 0.74μm, 单面存储容量为 4.7GB, 双面双层结构的为 17GB。DVD

光盘系列有 DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW 等多种类型。目前 DVD-Multi 已兼容了 DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM 三种光盘。上述这些产品的问世, 对包括音频、视频信息在内的数据的记录都发挥过巨大的作用。

3 蓝光存储及近场光存储

高清晰度电视 HDTV (High-Definition) 的投入使用, 要求研发出更高存储密度的光盘, 蓝光存储、近场光存储等应运而生。

3.1 蓝光存储

光存储密度与 $[NA / \lambda]^2$ 成正比, 所以提高存储密度首先想到的是缩短波长 和提高物镜的数值孔径 NA^[2]。随着 405nm 波长的蓝紫色半导体激光器的成功开发和商品化, 高密度激光视盘系统步入了第三代光存储时代。

Ricoh 公司推出的蓝光光盘, 采用 AgInSbTe 相变材料, 数值孔径为 0.6, 在普通盘面结构上进行槽岸同时记录实验, 得到单盘单面 12GB 存储容量, 30Mbit / s 数据输出^[3]。Sony 公司及其联盟推出的蓝光光盘有单面单层容量为 23GB, 25GB, 27GB 三种可擦写光盘和其它规格的光盘, 能存储 2h 的高清晰度视音频信号, 以及超过 13h 的标准电视信号。专业光盘, 单光头读写速率为 72Mbps, 双光头为 144Mbps, 可提供稳定的记录和高质量的图像, 实验素材节目的高速读写。NEC 公司研发的两种蓝光光盘, 数值孔径分别为 0.65 和 0.85。用户数据容量分别为 20GB 和 30GB。Toshiba 公司在改进相变材料的基础上, 采用槽岸记录方式与最大似然部分响应技术, 获得的单面存储容量是 18GB (NA=0.65) 和 30GB (NA=0.85), 且两者的最低信号误码率低于 5×10^{-5} , 擦写 10 次后还低于 1×10^{-4} 。Pioneer 公司采用新的信号处理技术等, 研制成功 27.4GB 双层只读光盘。以东芝为首的 HD DVD 联盟推出的光盘有: 只读单层 15GB, 双层 30GB, 可擦写单层 20GB, 双层 40GB 等。

Matsushita 公司制做的蓝光双层相变光盘, 第一层的记录功率为 8mW, 第二层的记录功率为 11mW, 信噪比大于 50dB, 可擦性超过 30dB, 其 120mm 单面盘面上的存储量为 27GB, 用户数据传输率为 33Mbit/s。之后他们又完成了数值孔径为 0.85 的相变高密度光存储实验^[4]。在研发的多层记录方式中, 使用波长 405nm 的激光器, 数值孔径为 0.85, 锯齿摆动记录格式的双层结构存储量为 45GB, 四层为 90GB。与 DVD 兼容 (数值孔径为 0.65) 的双层存储量为 27GB, 四层为 90GB。

3.2 近场光存储

为突破衍射分辨率极限, 研究人员提出了近场光存储。其主要原理是使用锥尖光纤作为数据读写的光头, 而且将光纤与盘光之间距离控制在纳米级, 使从光纤中射出的光在没有扩散之前就接触到盘面, 故称作近场记录。与传统的光存储方式相比, 近场光存储的存储容量大大提高。当光斑直径小于半个波长时, 存储密度就会提高几个数量级, 可达到 100GB 以上。光与物体相互作用时, 一种光是可以向远处传播的传播场, 另一种光是被局限在物体表面, 在物体之外迅速衰减的非辐射隐失场。隐失场是非均匀场, 其性质与样品的性质和结构有密切关系。物体亚波长结构的信息隐藏在隐失场中。因而利用近场隐失场可以获得超衍射极限的分辨率。目前国内外近场光存储研究主要集中在下述三个方面。

3.2.1 固体浸没透镜 (SIL) 近场存储

此技术主要依靠提高光学头的有效数值孔径来减小读写光斑的直径。固体浸没透镜与记录介质间的距离在近场范围内, 聚焦在 SIL 底面的光斑通过近场耦合, 传输隐失场的光, 在介质中记录信息。理论上光斑直径为 125nm, 相应存储密度为 $6.2\text{GB}/\text{cm}^2$, 且存储速度快。目前 SIL 存储还处在实验阶段。

贺锋涛等人采用波长为 650nm, 出射功率 10nW, 聚焦物镜数值孔径 0.65 的大功率激光头与 SIL 系统相结合, 在 CD-RW 相变光盘上实现了刻录线宽为 0.45 μm 的静态刻录结果。它与不采用 SIL 系统而其它条件相同的光存储相比, 记录线宽 (0.65 μm) 压缩了 1.44 倍^[5]。

3.2.2 超分辨率近场结构(Super-RENS)存储

Super-RENS 存储是传统的高分辨率光盘存储技术与近场光学技术的结合。它具有多层膜系。在距记录层 20nm 处是用 Sb 或 Ag_{0x} 材料做的掩膜层，作用与纳米孔径相同，故称为孔径开关层。在激光束的照射下，孔径开关层动态地产生非线性效应和表面等离子激元场增强效应，这样记录光束直径突破电磁衍射限制，在记录介质上形成纳米尺寸的记录点。

将 Super-RENS 技术与蓝光技术相结合，实现超高密度存储是目前研究的一个热点。Yamamoto 等人的实验，在氧化锌(ZnO)作掩膜的蓝光只读光盘上，线密度为普通蓝光只读光盘的 2 倍。Duseop Yoon 等人报导了将多膜结构用于蓝光只读光盘的可行性。Weichin Hsu 等人对无机一次写入型材料 SbNx 的蓝光超分辨实验，获得了更好的读出信号。使用 405nm 激光器，0.65 数值孔径的光学系统，其超分辨的读出为 60nm 记录符^[6]。Samsung 公司设计的适合 Blu-Ray 系统的超分辨近场结构，实现了 50nm 记录符(75GB)和 CNR 为 42.5dB 的有效读出^[7]。

3.2.3 探针扫描显微术(PSM)近场存储

它是基于原子刻度上的操作。借助于近场光学探针，将分辨率提高到原子水平的一种方法。蔡定平等人利用这种方法在一次性商用存储光盘上存入小于 100nm 的信息点。Partovi 等人改变了传统的光纤探针，采用直径为 250nm 的小孔径激光(波长为 980nm)获得了 250nm 的记录点。Gorecki 等人利用集成 PD 的 VCSEL 作为光源的方法，获得 200nm 的记录光斑直径^[8]。目前这种存储方法离商用化还有一些问题需要解决。

4 多阶光存储技术^[9]

多阶光存储是目前国内光存储研究的重点之一，缘于它可以大大地提高存储容量和数据传输率。在传统的光存储系统中，二元数据序列存储在记录介质中，记录符只有两种不同的物理状态，例如只读光盘中交替变化的坑岸形貌。多阶光存储是读出信号呈现多阶特性，或者直接采用多阶记录介质。多阶光存储分为信号多阶光存储和介质多阶光存储。

4.1 信号多阶光存储

其早期方案是坑深调制(PDM: Pit Depth Modulation)。在这种多阶只读光盘中，信息坑的宽度固定为 t_{min} ，信息坑的深度具有 M 种不同的可能，代表着不同的阶次。不同深度的信息坑，其读出光呈现不同光强，从而实现多阶坑深调制。Sony 公司研发的是利用信息坑边沿相对于固定时钟的变化，进行多阶信息存储，即利用信息坑长度的变化实现多阶光存储。信息坑的起始和结束边沿相对于时钟边沿都可以按一定的步长变化。若信息坑的起始和结束边沿的可能位置数均为 8，那么一个信息坑的边沿变化可能出现 64 种状态，信息坑可存储 6 比特(byte)的信息，因此显著高于传统光盘的记录密度。

4.2 介质多阶光存储

有多种介质可以用来实现多阶光存储。在电子俘获多阶技术中的光盘的记录层中掺杂有两种稀土元素，当第一种掺杂离子吸收短波长激光的光子后，其电子被激发到高能级状态，该电子可能被第二种掺杂离子“俘获”，实现数据的写入。用另一长波长激光(例如红光)将俘获的电子释放到原来的低能级状态，存储的能量以荧光的形式释放出来，由于发出的荧光强度与俘获的电子数量成比例，同时也与写入激光的强度成比例，该写入/读出过程具有线性响应，使得电子俘获材料适用于数字光存储。电子俘获光存储的反应速度快，可以实现 nS 时间的读写。

此外，通过调整退火时间和温度，控制相变材料的结晶程度，也可以实现多阶反射调制存储。

5 全息光存储

在第四代光盘中，全息光盘凭借其创新型思维和在光电器件、全息存储材料等研究领域取得的突破，成为未来海量存储消费市场上的新宠^[10]。在全息光存储中，存储介质是

一项关键技术。它关系到存储容量、传输速度、系统体积等。目前广泛使用的存储介质有光折变晶体，光折变聚合物，光致变色材料和光致聚合物。

全息光存储采用复用技术。其中空间复用，就是将不同的全息图（数据页）存储在介质的不同区域。体积复用包括角度复用、位相复用和波长复用。角度复用是每改变一次参考光的入射角，就完成一幅全息图的存储。位相复用中使用的是正交位相编码。波长复用是一个特定波长的光对应一幅全息图。混合复用技术，故名思义是将上述几种复用技术进行优势组合。全息光存储采用复用技术，可大幅度地提高存储容量和系统性能。

全息光存储以其存储密度高、超快存储速度、高冗余度和寻址速度快等优势，已成为存储领域研究的热点。2001年，IBM公司的全息存储实验密度为250GB/in²。2002年，Inphase公司展示的追记型全息记录介质播放系统的记录容量达100GB，可容纳30min的非压缩数字HDTV视频内容，数据传输速率为160Mbit/s。Aprlis公司在120mm标准盘面上，利用高性能全息存储介质实现了200GB存储容量和200Mbit/s的数据传输速度。2004年，Optware公司在美国加利福尼亚召开的光存储技术国际会议上，首次公开了全息光盘记录及播放装置。2006年，Inphase公司宣布已开发出一款全息光驱原型，该设备能提供高达1.6TB的容量，存储密度为515GB/in²。而目前使用的垂直记录的最高磁记录是170GB/in²。2007年该公司还与德国厂商DSM签OEM协议，承诺制造出存储容量为300GB、Tapestry300R的全息存储驱动器。2007年以色列的Mempile公司的多层存储系统实现了108层写入、读出结果，5微米层间距的典型层间干扰小于-35dB。2008年多阶存储技术采用多阶游程受限编码方法可以有效将DVD9结构光盘的存储容量提高60%，达到14GB的存储容量。

综上所述，光存储技术正处在升级换代的新阶段。随着新材料的使用，新技术的突破，光存储定会给人们生活带来更新更美的数字享受。

参考文献

- [1] 金国藩，张培坤. 超高密度光存储技术的现状和今后的发展 [J]. 中国计量学院学报，2001，13 (2): 6-12.
- [2] 徐端颐. 光盘存储系统设计原理 [M]. 北京：国防工业出版社，2000.
- [3] Shinotsuka M, Onagi N, Harigaya M. High-density and high-data transfer-rate optical disk with blue laser diode and Ag-In-Sb-Te phase-change material [J], Jpn. J. Appl. Phys., 2000, 39: 976-977
- [4] Shoji M, Nakamura A, Miyashita H. High-density recording on a phase-change rewritable disk using a 405nm blue laser diode [J], Jpn. J. Appl. Phys., 2002, 41: 1687-1688.
- [5] 贺锋涛，冯晓强，郝爱花. 固体浸没透镜静态光存储技术研究 [J]. 西安邮电学院学报，2007，12 (5): 70-72.
- [6] Hsu Wc, Tseng M R, Tsai S Y. Blue-laser readout properties of super resolution near field structure disk with inorganic write-once recording layer[J] Jpan J. Appl. Phys., 2003, 42:1005-1009.
- [7] Kim J, Kim H, Yoon D. Signal characteristics of super-resolution near-field

structure disk in blue laser system [J], Jpan. J. Appl. Phys. , 2004, 43:4921–4924.

[8] C. Gorecki, S. Khalfallah, H. Kawakatsu, et al. New SNOM sensor using optical feedback in a VCSEL-based compound-cavity [J]. Sensor & Actuators, 2001, 87:113–123.

[9] 胡华, 雷志军, 胡恒. 多阶光存储技术研究进展 [J] , 记录媒体技术, 2005, 2:16–20

[10] 郑光昭, 光信息科学与技术应用 [M], 北京: 电子工业出版社, 2002.